

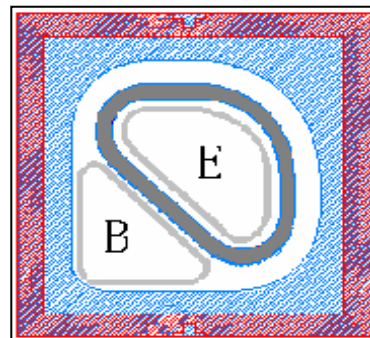


9015 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：C035BJ-00
芯片厚度： $240 \pm 20 \mu\text{m}$
管芯尺寸： $350 \times 350 \mu\text{m}^2$
焊位尺寸：B 极 $12150 \mu\text{m}^2$ ，E 极 $16180 \mu\text{m}^2$
电极金属：铝
背面金属：金
典型封装：SS9015，H9015

管芯示意图



极限值 ($T_a=25$) (封装形式：TO-92)

T_{stg} ——贮存温度.....-55~150
 T_j ——结温.....150
 P_C ——集电极耗散功率.....450mW
 V_{CBO} ——集电极—基极电压.....-50V
 V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....-45V
 V_{EBO} ——发射极—基极电压.....-5V
 I_C ——集电极电流.....-150mA

电参数 ($T_a=25$) (封装形式：TO-92)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.05	μA	$V_{\text{CB}}=-30\text{V}$ ， $I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-0.05	μA	$V_{\text{EB}}=-5\text{V}$ ， $I_C=0$
h_{FE}	直流电流增益	60		800		$V_{\text{CE}}=-5\text{V}$ ， $I_C=-1\text{mA}$
$V_{\text{CE}}(\text{sat})$	集电极—发射极饱和电压			-0.7	V	$I_C=-100\text{mA}$ ， $I_B=-5\text{mA}$
$V_{\text{BE}}(\text{sat})$	基极—发射极饱和电压			-1.0	V	$I_C=-100\text{mA}$ ， $I_B=-5\text{mA}$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-50			V	$I_C=-100\mu\text{A}$ ， $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-45			V	$I_C=-1\text{mA}$ ， $I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-100\mu\text{A}$ ， $I_C=0$
f_T	特征频率	100			MHz	$V_{\text{CE}}=-5\text{V}$ ， $I_C=-10\text{mA}$